



講師

吉田 俊幸 (よしだ としゆき)

総合理工学部 3号館 811室

TEL: 0852-32-6346 (内線 6314)

Email: yosisi[at]riko.shimane-u.ac.jp ([at]を@に変えて下さい)

研究室 HP: http://www.ecs.shimane-u.ac.jp/~yosisi/index_J.html

略歴

- 2000 日本学術振興会 特別研究員
- 2001 北海道大学大学院 工学研究科 電子情報工学専攻 博士課程 修了
- 2001 島根大学 総合理工学部 電子制御システム工学科 助手
- 2007 島根大学 総合理工学部 電子制御システム工学科 助教
- 2012 島根大学 総合理工学部 機械・電気電子工学科 助教
- 2018 島根大学 総合理工学部 物理・マテリアル工学科 助教
- 2019 島根大学 総合理工学部 物理・マテリアル工学科 講師

研究内容

半導体薄膜および微粒子層の表面／界面評価とデバイス応用

主要論文

1. Toshiyuki Yoshida, Islam Md Maruful, and Yasuhisa Fujita: "Trial of Ga-doping on ZnO Nanoparticles by Thermal Treatment with Ga₂O₃ Nanoparticles", e-Journal of Surface Science and Nanotechnology, **18** (2020) pp.12-17.
2. Itohara Daiki, Kazato Shinohara, Toshiyuki Yoshida, and Yasuhisa Fujita: "P-channel and n-channel thin-film-transistor operation on sprayed ZnO nanoparticle layers", Journal of Nanomaterials, **2016** (2016) pp.8219326_1-6.
3. Toshiyuki Yoshida, and Tamotsu Hashizume: "Studies on atomic layer deposition Al₂O₃/In_{0.53}Ga_{0.47}As interface formation mechanism based on air-gap capacitance-voltage method", Applied Physics Letters, **101** (2012) pp.122102_1-4.
4. Toshiyuki Yoshida, Yoshiki Ebiko, Michiko Takei, Nobuo Sasaki, and Toshiaki Tsuchiya: "Grain-Boundary Related Hot Carrier Degradation Mechanism in Low-Temperature Polycrystalline Silicon Thin-Film Transistors", Japanese Journal of Applied Physics, Part 1, **42** 4B (2003) pp. 1999-2003.